



博学而笃志 切问而近思

站内搜索: [搜索](#)



茹国平

系别: 微电子学系
职称: 教授 博导
职务:
办公 微电子学楼311室
室:
电话: 021-65643561
E-mail: gpru@fudan.edu.cn
主页: <http://sme.fudan.edu.cn/faculty/personweb/ruguoping/index.htm>

教育背景

- 7/1/1990 南京大学物理学系 本科学士
- 8/1/1995 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 博士研究生
- 10/1/1997至10/1/1998 比利时根特大学固态科学系 访问学者

研究方向

金属硅化物接触技术, 微电子器件建模与模拟

课程教学

- 本科课程: 半导体物理、半导体器件原理、半导体光电子器件
- 研究生课程: 半导体器件物理、半导体器件工艺新技术、电子器件薄膜新材料

IEEE高级会员

科研项目

上海一应用材料研究与发展基金：锗硅器件接触技术研究

教育部中德国际合作项目：先进互连材料及概念

国家自然科学基金：金属/锗硅固相反应及其与杂质相互作用研究

上海市自然科学基金：全硅化物化金属栅材料与工艺研究

论文著作

1. Appl. Surf. Sci., 255, 1744 (2008), Pre-doping effects on Ni fully silicided metal gate on SiO₂ dielectric, , ,
2. Proc. of ICSICT?2008, p. 1264, Alloying effects in Ni silicide for CMOS applications, , ,
3. Microelectron. Eng., 85, 2032 (2008), Characterization of Ni/Ho and Ni/Er fully silicided metal gates on SiO₂ gate dielectric, , ,
4. Thin Solid Films, 516, 4252 (2008), Improvement of Er-silicide formation on Si (100) by W capping, , ,
5. J. Vac. Sci. Technol. B, 26, 164 (2008), Erbium silicide formation and its contact properties on Si(100), , ,
6. Appl. Surf. Sci., 254, 2120 (2008), Effect of erbium interlayer on nickel silicide formation on Si(100), , ,
7. Microelectron. Eng., 85, 131 (2008), Yttrium silicide formation and its contact properties on Si(100), , ,
8. 复旦学报（自然科学版），反应离子刻蚀剥层的微分霍尔法表征超浅PN结, , ,
9. 半导体学报, Effect of Pt addition on the stress of NiSi film formed on Si (100), , ,
10. 半导体学报, 电化学电容-电压法表征等离子体掺杂超浅结, , ,
11. Extended Abstracts of IWJT-2005, p. 79. (邀请报告), Ti-capping and heating ramp-rate effects on Ni-silicide film and interface, , ,
12. Solid-State Electron., 49, 606 (2005), Voltage dependence of effective barrier height reduction in inhomogeneous Schottky diodes, , ,

获奖情况

1999----教育部科技进步三等奖

[返回](#)